



一种刻蚀基板外延定向生长氮化物纳米片网格的方法

文献类型: 专利

作者 丛洪涛, 唐永炳 and 成会明

发表日期 2008-09-03

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 一种刻蚀基板外延定向生长AIN纳米片网格的方法,采用刻蚀Si 基板和反应物气相蒸发法制备垂直排列的AIN纳米片蜂窝状网格,首先用含1-5%的氢氟酸或盐酸腐蚀液刻蚀Si片1-20min,然后去除表面的氧化硅 薄膜,用Al+AlCl₃作反应物放置在真空CVD炉的恒温区,刻蚀后的Si片 作沉积基板放在出气端,用蒸发法制备出具有蜂窝状网格形状的AIN纳米片。这种Si基板自生模板,与常规氧化铝多孔模板相比,可避免外加模板 的杂质污染和清除模板时所生长纳米结构的破坏。又因为Si基板表面的 刻蚀沟槽是连通的,所以这种刻蚀基...

公开日期 2008-09-03

语种 中文

专利申请号 CN101256950

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/67171]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 丛洪涛, 唐永炳 and 成会明. 一种刻蚀基板外延定向生长氮化物纳米片网格的方法. 2008-09-03.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
115	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。